



CAS IR Grid / 合肥物质科学研究院 / 中国科学院合肥物质科学研究院 / 中科院固体物理研究所

## Ge掺杂的\_相三氧化二铁纳米片阵列薄膜的制备方法\_

文献类型: 专利

作者 梁长浩 ; 刘俊 ; 叶一星

专利号 cn1003693861a

著作权人 中国科学院合肥物质研究院

国家 中国

文献子类 发明专利

语种 中文

源URL [http://ir.hfcas.ac.cn:8080/handle/334002/92898]

专题 合肥物质科学研究院\_中科院固体物理研究所

推荐引用方式 梁长浩,刘俊,叶一星. Ge掺杂的\_相三氧化二铁纳米片阵列薄膜的制备方法\_. cn1003693861a.

**GB/T 7714**

入库方式: OAI收割

来源: [合肥物质科学研究院](#)

浏览

65

下载

2

收藏

0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。